

PCT/JPC3/16513

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

24.12.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application:

2002年12月25日

出願番号  
Application Number:

特願2002-374396

[ST. 10/C]: [JP2002-374396]

出願人  
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

REC'D 19 FEB 2004

WIPO

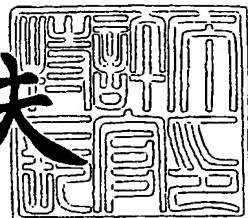
PCT

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 2月 5日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願  
【整理番号】 2161740020  
【提出日】 平成14年12月25日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H03H 9/25  
【発明者】  
【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内  
【氏名】 高山 了一  
【発明者】  
【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内  
【氏名】 中西 秀和  
【発明者】  
【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内  
【氏名】 井上 孝  
【発明者】  
【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内  
【氏名】 川崎 哲生  
【発明者】  
【住所又は居所】 北海道室蘭市水元町27-1 室蘭工業大学 電子電気工学科内  
【氏名】 長谷川 弘治  
【特許出願人】  
【識別番号】 000005821  
【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

## 【代理人】

【識別番号】 100097445

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子部品およびこの電子部品を用いた電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、この基板の上面に設けた櫛型電極と、この櫛型電極を覆うとともに天面に凹凸形状を有する保護膜とを備え、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凸部の頂部までの高さを  $t$ 、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凹部の底部までの高さを  $t_1$ 、この保護膜の凸部の頂部からこの保護膜の凹部の底部までの高さ ( $t - t_1$ ) を  $t_2$  とし、この保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりのピッチ幅を  $L$ 、前記保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりの凹凸の凸部の幅を  $L_1$ 、凹部の幅を  $L_2$ 、前記櫛型電極の1ピッチあたりのピッチ幅を  $p$ 、前記櫛形電極を構成する電極指1本あたりの幅を  $p_1$ 、前記電極指間の幅を  $p_2$ 、前記櫛型電極の膜厚を  $h$ としたとき、

$$h \leq t_2$$

(ただし、 $L = p$ 、 $p_1 + p_2 = p$ 、 $L_1 + p_2 = L$ 、 $L_1 \leq p_1$ 、 $L_2 \geq p_2$  の関係を満たす)」

である電子部品。

【請求項2】 基板上に設けられた櫛型電極において、前記櫛型電極の膜厚  $h$  と前記櫛型電極の1ピッチあたりのピッチ幅  $p$ との関係が、

$$h / (2 \times p) \leq 0.05$$

である請求項1記載の電子部品。

【請求項3】 基板と、この基板の上面に設けた櫛型電極と、この櫛型電極を覆うとともに天面に凹凸形状を有する保護膜とを備え、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凸部の頂部までの高さを  $t$ 、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凹部の底部までの高さを  $t_1$ 、この保護膜の凸部の頂部からこの保護膜の凹部の底部までの高さ ( $t - t_1$ ) を  $t_2$  とし、この保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりのピッチ幅を  $L$ 、前記保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりの凹凸の凸部の幅を  $L_1$ 、凹部の幅を  $L_2$ 、前記櫛型電極の1ピッチあたりのピッチ幅を  $p$ 、前記櫛形電極を構成する電極指1本あたりの幅を  $p_1$ 、前記電極指間の幅を  $p_2$ 、前記櫛型電極の膜厚を  $h$ としたとき、

$$t_2 \leq h$$

(ただし、 $L = p$ 、 $p_1 + p_2 = p$ 、 $L_1 + p L_2 = L$ 、 $L_1 \leq p_1$ 、 $L_2 \geq p_2$ の関係を満たす)」

である電子部品。

**【請求項4】** 基板上に設けられた櫛型電極において、前記櫛型電極の膜厚 $h$ と前記櫛型電極の1ピッチあたりのピッチ幅 $p$ との関係が、

$$0.05 \leq h / (2 \times p)$$

である請求項3記載の電子部品。

**【請求項5】** 1ピッチあたりの保護膜のピッチ幅 $L$ と、前記保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりの凹凸の凸部の幅 $L_1$ との比 $L_1/L$ を $\eta$ とし、1ピッチあたりの櫛型電極のピッチ幅 $p$ と、前記櫛型電極を構成する電極指1本あたりの幅 $p_1$ との比 $p_1/p$ を $\eta'$ と $\eta$ との関係が、

$$\eta - 0.3 \leq \eta' \leq \eta$$

(ただし、 $L = p$ 、 $p_1 + p_2 = p$ 、 $L_1 + p L_2 = L$ の関係を満たす)」  
である請求項1または3のいずれかに記載の電子部品。

**【請求項6】** 1ピッチあたりの保護膜の凹凸の凸部の幅 $L_1$ の中心を $L_c$ とし、前記1ピッチあたりの保護膜の凸部の下に位置する櫛型電極の電極指の幅 $p$ の中心を $p_c$ としたとき、 $L_c$ と $p_c$ がほぼ同一直線上に存在している請求項1または3のいずれかに記載の電子部品。

**【請求項7】** 基板は、タンタル酸リチウム基板であって、かつこのタンタル酸リチウム基板の切出し角度が、X軸周りにZ軸方向への回転角度を $D^\circ$ とした場合、

$$38^\circ \leq D^\circ$$

のY板から切り出されたものである請求項1または3のいずれかに記載の電子部品。

**【請求項8】** 基板の上面に設けた櫛型電極と、この櫛型電極を覆うとともに天面に凹凸形状を有する保護膜は、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凹部の底部までの高さ $t_1$ と、櫛型電極の1ピッチあたりのピッチ幅 $p$ の関係が、

「 $18\% \leq t_1 / (2 \times p) \leq 35\%$ 」

である請求項1または3のいずれかに記載の電子部品。

**【請求項9】** 保護膜は、二酸化シリコンである請求項1または3のいずれかに記載の電子部品。

**【請求項10】** 基板と、この基板の上面に設けた櫛型電極と、この櫛型電極を覆うように設けた保護膜とを備え、この保護膜の天面はほぼ平坦であって、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の上面までの高さをt、前記櫛型電極の1ピッチあたりのピッチ幅をpとしたとき、前記基板は、タンタル酸リチウム基板であって、かつこのタンタル酸リチウム基板の切出し角度が、X軸周りのZ軸方向への回転角度をD°とした場合、

「 $38^\circ \leq D^\circ$ 」

のY板から切出されたものであり、かつ

「 $18\% \leq t / (2 \times p) \leq 35\%$ 」

である電子部品。

**【請求項11】** 少なくとも1つ以上のアンテナと、前記アンテナに接続された電気回路を有する電子機器であって、前記電気回路は複数の電子部品を備え、この複数の電子部品の少なくとも一つは、基板と、この基板の上面に設けた櫛型電極と、この櫛型電極を覆うとともに天面に凹凸形状を有する保護膜とを備え、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凸部の頂部までの高さをt、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凹部の底部までの高さをt<sub>1</sub>、この保護膜の凸部の頂部からこの保護膜の凹部の底部までの高さ(t-t<sub>1</sub>)をt<sub>2</sub>とし、この保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりのピッチ幅をL、前記保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりの凹凸の凸部の幅をL<sub>1</sub>、凹部の幅をL<sub>2</sub>、前記櫛型電極の1ピッチあたりのピッチ幅をp、前記櫛形電極を構成する電極指1本あたりの幅をp<sub>1</sub>、前記電極指間の幅をp<sub>2</sub>、前記櫛型電極の膜厚をhとしたとき、

「 $h \leq t_2$

(ただし、 $L = p$ 、 $p_1 + p_2 = p$ 、 $L_1 + p_2 = L$ 、 $L_1 \leq p_1$ 、 $L_2 \leq p_2$ の関係を満たす)」

である電子部品である電子機器。

【請求項12】 少なくとも1つ以上のアンテナと、前記アンテナに接続された電気回路を有する電子機器であって、前記電気回路は複数の電子部品を備え、この複数の電子部品の少なくとも一つは、基板と、この基板の上面に設けた樹型電極と、この樹型電極を覆うとともに天面に凹凸形状を有する保護膜とを備え、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凸部の頂部までの高さを $t$ 、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凹部の底部までの高さを $t_1$ 、この保護膜の凸部の頂部からこの保護膜の凹部の底部までの高さ( $t - t_1$ )を $t_2$ とし、この保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりのピッチ幅を $L$ 、前記保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりの凹凸の凸部の幅を $L_1$ 、凹部の幅を $L_2$ 、前記樹型電極の1ピッチあたりのピッチ幅を $p$ 、前記樹型電極を構成する電極指1本あたりの幅を $p_1$ 、前記電極指間の幅を $p_2$ 、前記樹型電極の膜厚を $h$ としたとき、

$$t_2 \leq h$$

(ただし、 $L = p$ 、 $p_1 + p_2 = p$ 、 $L_1 + p_2 = L$ 、 $L_1 \leq p_1$ 、 $L_2 \leq p_2$ の関係を満たす)」

である電子部品である電子機器。

【請求項13】 少なくとも1つ以上のアンテナと、前記アンテナに接続された電気回路を有する電子機器であって、前記電気回路は複数の電子部品を備え、この複数の電子部品の少なくとも一つは、基板と、この基板の上面に設けた樹型電極と、この樹型電極を覆うように設けた保護膜とを備え、この保護膜の上面はほぼ平坦であって、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の上面までの高さを $t$ 、前記樹型電極の1ピッチあたりのピッチ幅を $p$ としたとき、前記基板は、タンタル酸リチウム基板であって、かつこのタンタル酸リチウム基板の切出し角度が、X軸周りにZ軸方向への回転角度を $D^\circ$ とした場合、

$$38^\circ \leq D^\circ$$

のY板から切り出されたものであり、かつ

$$18\% \leq t / (2 \times p) \leq 35\%$$

である電子部品である電子機器。

**【発明の詳細な説明】****【0001】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、電子部品およびこの電子部品を用いた電子機器に関するものである。

**【0002】****【従来の技術】**

以下、従来の電子部品について説明する。

**【0003】**

本従来の技術では、電子部品の一例として弾性表面波デバイス（以下、「SAWデバイス」と記す。）を例にとり説明する。

**【0004】**

近年、小型軽量な SAW デバイスは、各種移動体通信端末機器等の電子機器に多く使用されている。特に、800MHz ~ 2GHz 帯における携帯電話システムの無線回路部には、タンタル酸リチウム（以下、「LT」と記す。）基板の切出角度が、X 軸周りの Z 軸方向への回転角度が 36° である Y 板から切出された、いわゆる 36° Y カット X 伝播の LT（以下、「36° YLT」と記す。）基板を用いて作成した SAW フィルタが広く用いられてきた。しかし、携帯電話のシステムやその無線回路部におけるフィルタの使用箇所によっては、さらなる通過帯域の低挿入損失化およびフィルタのスカート特性が急峻で、かつ阻止域における抑圧度の高いフィルタ特性が要求されている。この様な要求を満たすため、LT 基板の切出角度が、X 軸周りの Z 軸方向への回転角度が 42° である Y 板から切出された、いわゆる 42° Y カット X 伝播の LT（以下、「42° YLT」と記す。）基板を用いることで、従来の 36° YLT 基板を用いるよりも、より低損失かつフィルタのスカート特性が急峻な SAW フィルタを実現する方法が、特許文献 1 に示されている。

**【0005】****【特許文献 1】**

特開平 9-167936 号公報

**【0006】****【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、 $42^{\circ}$  YLT基板は、従来の $36^{\circ}$  YLT基板同様、弾性表面波の伝播方向の基板の熱膨張係数が大きく、また弾性定数そのものも温度により変化するため、フィルタの周波数特性も温度の変化に対して約 $-35 \text{ ppm}/^{\circ}\text{K}$ と、大きくシフトしてしまうという、温度特性に課題を有していた。例えばアメリカのPCS用の送信フィルタを例にとって考えた場合、常温で中心周波数 $1.88 \text{ GHz}$ のフィルタが、常温± $50^{\circ}\text{C}$ で、約± $3.3 \text{ MHz}$ つまり約 $6.6 \text{ MHz}$ も変動する。PCSの場合、送信帯域と受信帯域の間隔は $20 \text{ MHz}$ しかなく、製造上の周波数ばらつきも考慮すると、フィルタにとっての送受信間隔は実質 $10 \text{ MHz}$ 程度しかない。このため、例えば送信帯域を全温度（常温± $50^{\circ}\text{C}$ ）で確保しようとすると受信側の減衰量が十分に取れなくなるという問題を有していた。

**【0007】**

本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、電極上に保護膜を形成することによって温度特性および電気的特性が優れた電子部品を得ることを目的とするものである。

**【0008】****【課題を解決するための手段】**

上記目的を達成するために、本発明の第1の発明は、電子部品に設けた天面に凹凸形状を有する保護膜は、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凸部の頂部までの高さを $t$ 、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凹部の底部までの高さを $t_1$ 、この保護膜の凸部の頂部からこの保護膜の凹部の底部までの高さ（ $t - t_1$ ）を $t_2$ とし、この保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりのピッチ幅を $L$ 、前記保護膜の凹凸形状の1ピッチあたりの凹凸の凸部の幅を $L_1$ 、凹部の幅を $L_2$ 、前記樹型電極の1ピッチあたりのピッチ幅を $p$ 、前記樹形電極を構成する電極指1本あたりの幅を $p_1$ 、前記電極指間の幅を $p_2$ 、前記樹型電極の膜厚を $h$ としたとき、

$$h < t_2$$

(ただし、 $L \neq p$ 、 $p_1 + p_2 = p$ 、 $L_1 + p L_2 = L$ 、 $L_1 \leq p_1$ 、 $L_2 \geq p_2$ の関係を満たす)」であるもので、保護膜が電極を覆うように形成された場合でも、電極部分と分極指間との間に基板にかかる質量の差を設けることで、電極端部における SAW の反射係数の低下を抑制、または向上させることができ、小型で特性の良い電子部品を得ることができるという作用を有する。

### 【0009】

また、第2の発明は、電子部品に設けた天面に凹凸形状を有する保護膜は、保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凸部の頂部までの高さを  $t$ 、この保護膜と接する前記基板の表面からこの保護膜の凹部の底部までの高さを  $t_1$ 、この保護膜の凸部の頂部からこの保護膜の凹部の底部までの高さ ( $t - t_1$ ) を  $t_2$  とし、この保護膜の凹凸形状の 1 ピッチあたりのピッチ幅を  $L$ 、前記保護膜の凹凸形状の 1 ピッチあたりの凹凸の凸部の幅を  $L_1$ 、凹部の幅を  $L_2$ 、前記樹型電極の 1 ピッチあたりのピッチ幅を  $p$ 、前記樹形電極を構成する電極指 1 本あたりの幅を  $p_1$ 、前記電極指間の幅を  $p_2$ 、前記樹型電極の膜厚を  $h$  としたとき、

$$t_2 \leq h$$

(ただし、 $L \neq p$ 、 $p_1 + p_2 = p$ 、 $L_1 + p L_2 = L$ 、 $L_1 \leq p_1$ 、 $L_2 \leq p_2$  の関係を満たす)」であるもので、電極上の保護膜の形状の影響を減らし、不要な SAW の反射の発生を抑える事により、結果として、保護膜が電極を覆うように形成され、かつその表面に凸凹状態が存在する場合においても、特性の良い電子部品を得ることができるという作用を有する。

### 【0010】

また、第3の発明は、電子部品に設けた天面がほぼ平坦な保護膜は、保護膜と接する前記基板表面からこの保護膜の上面までの高さを  $t$ 、前記樹型電極の 1 ピッチあたりのピッチ幅を  $p$  としたとき、前記基板は、タンタル酸リチウム基板であって、かつこのタンタル酸リチウム基板の切出し角度が、X 軸周りに Z 軸方向への回転角度を  $D^\circ$  とした場合、

$$38^\circ \leq D^\circ$$

の Y 板から切り出されたものであり、かつ

「 $18\% \leq t / (2 \times p) \leq 35\%$ 」

とすることで、温度特性の変化が少なく、かつ特性の良好な電子部品を得ることができるという作用を有する。

### 【0011】

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態における電子部品について、図面を参照しながら説明する。本実施の形態では電子部品の一例として SAW デバイスを例にして説明する。

### 【0012】

#### (実施の形態 1)

図 1 (a) は本発明の実施の形態 1 における電子部品としての SAW デバイスの上面図、図 1 (b) は同断面図である。

### 【0013】

同図に示すように本実施の形態 1 の SAW デバイスは、基板 1 の上面に櫛型電極 2 を、この櫛型電極 2 の両側に反射器 3 とを備え、少なくともこれら櫛型電極 2 および反射器 3 を覆う保護膜 4 を備えるものである。さらに櫛型電極 2 には、この櫛型電極 2 と電気的に接続された電気信号の取出しを行うパッド 5 を有し、SAW デバイスを構成するものである。

### 【0014】

基板 1 は、X 軸周りに Z 軸方向へ数度回転させた Y 板から切出したタンタル酸リチウムからなるもので、その回転の角度が  $36^\circ$  である  $36^\circ$  YLT 基板である。

### 【0015】

櫛型電極 2 はアルミニウム（以下、「A1」と記する。）または A1 合金からなるものである。

### 【0016】

保護膜 4 は、好ましくは二酸化シリコン（以下、「SiO<sub>2</sub>」と記する。）からなるもので、図 1 (b) に示すように、その天面には凹凸形状を備えている。保護膜 4 の凸部分 4a は、基板 1 の上面の櫛型電極 2 を有する部分の上方に備え

ている。また、保護膜4の凹部分4bは、凸部分4a間の樹型電極2が基板1の上面に存在しない部分およびその近傍に備えている。

#### 【0017】

ここで、保護膜4が接している基板1の表面から、保護膜4の凸部分4aの頂部までの高さをtとし、保護膜4が接している基板1の表面から、保護膜4の凹部分4bの底部までの高さをt1とし、保護膜4の凹部分4bの底部から凸部分4aの頂部までの高さ(t-t1)をt2とする。

#### 【0018】

また、保護膜4が接している基板1の表面から、電極指2aの頂部までを樹型電極2の高さhとする。

#### 【0019】

さらに保護膜4の凸部分4a、凹部分4b各々1つを1ピッチとし、この1ピッチあたりのピッチ幅をLとし、保護膜4の凸部分4aの幅をL1とし、保護膜4の凹部分4bの幅をL2(L=L1+L2が成り立つこと)とする。また、保護膜4の1ピッチと同様に、1つの樹型電極2の電極指2aおよび一方が隣合う電極指2aの存在する部分までを樹型電極2の1ピッチ幅pとする。

#### 【0020】

また、電極指2aの1本あたりの幅をp1とし、隣合う電極指間の幅をp2(p=p1+p2が成り立つこと)とする。

#### 【0021】

また、保護膜4のピッチ幅Lと保護膜4の凸部分4aの幅Lとの比L1/Lをη'、樹型電極2の1ピッチ幅pと電極指1本あたりの幅p1との比p1/pをηとする。

#### 【0022】

本発明の実施の形態1においては、

$$h < t_2$$

(ただし、 $L = p$ 、 $p_1 + p_2 = p$ 、 $L_1 + p_2 = L$ 、 $L_1 \leq p_1$ 、 $L_2 \geq p_2$ の関係を満たす)」の関係を満たすものである。

#### 【0023】

また、上述した基板1には36° YLT基板を用いたが、この基板1を、X軸周りにZ軸方向へD°回転させたY板から切出したLTとして、その回転の角度D°が

$$38^\circ \leq D^\circ$$

であるD° YLT基板を用いても同様の効果を奏する。

#### 【0024】

また、保護膜4のピッチ幅Lと保護膜4の凸部分4aの幅L1との比 $\eta'$ と樹型電極2の1ピッチ幅pと電極指1本あたりの幅p1との比 $\eta$ との間に、

$$\eta - 0.3 \leq \eta' \leq \eta$$

の関係が成り立っていることが好ましい。

#### 【0025】

また、保護膜4の凸部分4aの幅L1の中心をLc、この保護膜4の凸部分4aの下方およびその近辺に存在する電極指2の1本あたりの幅p1の中心をpcとした場合、Lcとpcとがほぼ同一直線状に存在していることが好ましい。

#### 【0026】

以上のように構成されるSAWデバイスについて、以下にその製造方法を図面を参照しながら説明する。

#### 【0027】

図2は本発明の実施の形態1におけるSAWデバイスの製造方法を説明する図である。

#### 【0028】

まず、図2(a)に示すように、LT基板21の上面にAlまたはAl合金を蒸着またはスパッタ等の方法により樹型電極または／および反射器となる電極膜22を成膜する。

#### 【0029】

次に、図2(b)に示すように、電極膜22の上面にレジスト膜23を形成する。

#### 【0030】

次に、図2(c)に示すように、所望の形状となるように露光・現像技術等を

用いてレジスト膜23を加工する。

#### 【0031】

次に、図2(d)に示すように、ドライエッティング技術等を用いて電極膜22を樹型電極や反射器等、所望の形状に加工した後、レジスト膜23を除去する。

#### 【0032】

次に、図2(e)に示すように、電極膜22を覆うようにSiO<sub>2</sub>を蒸着またはスパッタ等の方法により、保護膜24を形成する。

#### 【0033】

次に、さらに図2(f)に示すように、保護膜24の表面にレジスト膜25を形成する。

#### 【0034】

次に、図2(g)に示すように、露光・現像技術等を用いてレジスト膜25を所望の形状に加工する。

#### 【0035】

次に、図2(h)に示すように、ドライエッティング技術等を用いて、電気信号取出しのためのパッド26等、保護膜24が不要な部分の保護膜を取り除き、その後、レジスト膜25を除去する。

#### 【0036】

最後にダイシングにより個々に分割した後、セラミックパッケージにダイボンド等によりマウントし、ワイヤーボンディング後、蓋を溶接し気密封止を行った。

#### 【0037】

なお、発明者らは、上述されたSAWデバイスの作成に関して、本実施の形態1において、樹型電極2の厚さhと樹型電極2の1ピッチあたりのピッチ幅pとの関係が

$$0.05 \leq h / (2 \times p)$$

のとき、必要とする保護膜の形状を、比較的達成しやすいことを見出している。以上のようにして作成されたSAWデバイスについて、電気的特性を調べた。その結果、発明者らは良い特性が得られることを確認した。

**【0038】**

また、発明者らは温度特性に関しても調べた結果、保護膜としてSiO<sub>2</sub>を用い、基板表面から前記保護膜の凹部までの高さtが

$$18\% \leq t / (2 \times p) \leq 35\%$$

の条件を満たしている場合に良好な温度特性が得られることも合わせて確認した。

**【0039】**

(実施の形態2)

以下、本発明の実施の形態2におけるSAWデバイスについて図面を参照しながら説明する。

**【0040】**

本実施の形態2においてSAWデバイスは、実施の形態1と同様のSAWデバイスを用いた。図3は本発明の実施の形態2におけるSAWデバイスの断面図である。本図において、実施の形態1で用いた図1(b)と同様の構成は同一符号を付し、その説明は省略する。

**【0041】**

保護膜34は、好ましくはSiO<sub>2</sub>からなるもので、図3に示すように、その天面は凹凸形状を備えている。保護膜34の凸部分34aは、基板1の上面の櫛型電極32を有する部分の上方に備えている。また、保護膜34の凹部分34bは、凸部分34a間の櫛型電極32が基板1の上面に存在しない部分およびその近傍に備えている。

**【0042】**

ここで、保護膜34が接している基板1の表面から、保護膜34の凸部分34aの頂部までの高さをtとし、保護膜34が接している基板1の表面から、保護膜34の凹部分34bの底部までの高さをt<sub>1</sub>とし、保護膜34の凹部分34bの底部から凸部分34aの頂部までの高さ(t-t<sub>1</sub>)をt<sub>2</sub>とする。

**【0043】**

さらに保護膜34の凸部分34a、凹部分34b各々1つを1ピッチとし、この1ピッチあたりのピッチ幅をLとし、保護膜34の凸部分34aの幅をL<sub>1</sub>と

し、保護膜34の凹部分34bの幅をL2（ $L = L_1 + L_2$  が成り立つこと）とする。

#### 【0044】

本実施の形態2と実施の形態1の図1（b）とが相違する点は、実施の形態1の図1（b）の保護膜4の凹部分4bの底部から凸部分4aの頂部までの高さt2が櫛型電極2の高さhより高いのに対し、発明の実施の形態2の図3では、保護膜34の凹部分34bの底部から凸部分34aの頂部までの高さt2が櫛型電極2の高さh以下である点が相違する。

#### 【0045】

本発明の実施の形態2においては、

$$t_2 \leq h$$

（ただし、 $L = p_1 + p_2 = p$ 、 $L_1 + p_2 = L$ 、 $L_1 \leq p_1$ 、 $L_2 \geq p_2$  の関係を満たす）」の関係を満たすものである。

#### 【0046】

なお、本実施の形態2における、SAWデバイスの作成方法は、実施の形態1で説明した方法と同様であるので、説明は省略する。

#### 【0047】

以上のように構成したSAWデバイスについて、発明者らが電気的特性について調べた結果、良い特性が得られることを確認した。

#### 【0048】

また、本実施の形態2においては、櫛型電極の膜厚hと、この櫛型電極の1ピッチあたりのピッチ幅pとの関係が、

$$0.05 \leq h / (2 \times p)$$

であることが特性上、より好ましい。

#### 【0049】

さらに、温度特性についても調べた結果、保護膜としてSiO<sub>2</sub>を用い、基板表面から前記保護膜の凹部までの高さt1が

$$18\% \leq t_1 / (2 \times p) \leq 35\%$$

の条件を満たしている場合に良好な温度特性が得られることも合わせて確認した

**【0050】**

(実施の形態3)

以下本発明の実施の形態3におけるSAWデバイスについて図面を参照しながら説明する。

**【0051】**

本実施の形態3においてSAWデバイスは、実施の形態1と同様のSAWデバイスを用いた。図4は本発明の実施の形態3におけるSAWデバイスの断面図である。本図において、実施の形態3で用いた図1（b）と同様の構成は同一符号を付し、その説明は省略する。

**【0052】**

保護膜44は、好ましくはSiO<sub>2</sub>からなるもので、図4に示すように、その天面44aはほぼ平坦な形状を備えている。

**【0053】**

ここで、保護膜44が接している基板1の表面から、保護膜44の天面44aまでの高さをtとする。

**【0054】**

本実施の形態3と実施の形態1の図1（b）とが相違する点は、実施の形態1の図1（b）の保護膜4が、その天面に凹凸形状を備えているのに対し、実施の形態3の図4では、保護膜44の天面がほぼ平坦である点が相違する。

**【0055】**

本発明の実施の形態3においては、基板1は、X軸周りにZ軸方向へ数度回転させたY板から切出したタンタル酸リチウムからなるもので、その回転の角度をD°とした場合、

$$38^\circ \leq D^\circ$$

であり、かつ、保護膜44の高さtと櫛型電極2のピッチ幅pが

$$18\% \leq t / (2 \times p) \leq 35\%$$

の関係を満たすものである。

**【0056】**

なお、本実施の形態3における、SAWデバイスの作成方法は、実施の形態1で説明した方法と同様であるので、説明は省略する。

#### 【0057】

以上のように構成したSAWデバイスについて、発明者らが電気的特性について調べた結果、良い特性が得られることを確認した。

#### 【0058】

(実施の形態4)

以下に本発明の、実施の形態4における電子機器について図面を参照しながら説明する。

#### 【0059】

本実施の形態では、電子機器の一例として携帯電話を例にとり説明する。

#### 【0060】

図5(a)は本発明の実施の形態4における、携帯電話の概観図、図5(b)は同内部の要部電気回路図である。

#### 【0061】

同図に示すように本実施の形態5の携帯電話は、アンテナ51およびこのアンテナ51に接続されたアンテナ共用器52を有している。このアンテナ共用器52は、送信用SAWフィルタ52a、受信用SAWフィルタ52b、および移相回路52cにより構成する。

#### 【0062】

本実施の形態における送信用SAWフィルタ52aおよび受信用SAWフィルタ52bは、実施の形態1～3で説明した何れかのSAWデバイスを用いるものである。

#### 【0063】

以上のように構成した携帯電話に対して、発明者らは、その感度を-25℃から85℃の環境下で測定したところ、温度変化に対して、感度の変化が少ないことを確認した。

#### 【0064】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、基板上に形成された電極を覆うように保護膜を形成し、かつその保護膜の形状や厚さを特定の範囲に設定することによって温度特性および電気的特性が優れるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

- (a) 本発明の実施の形態 1 における電子部品の構成を示す上面図
- (b) 同断面図

【図 2】

本発明の実施の形態 1 における電子部品の製造方法を説明する図

【図 3】

本発明の実施の形態 2 における電子部品の断面図

【図 4】

本発明の実施の形態 3 における電子部品の断面図

【図 5】

- (a) 本発明の実施の形態 4 における電子部品の概観図
- (b) 同内部の要部電気回路図

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 櫛型電極
- 2 a 電極指
- 3 反射器
- 4 保護膜
- 4 a 保護膜の凸部分
- 4 b 保護膜の凹部分
- 5 パッド
- 2 1 基板
- 2 2 電極膜
- 2 3 レジスト膜
- 2 4 保護膜

25 レジスト膜

26 パッド

34 保護膜

34a 保護膜の凸部分

34b 保護膜の凹部分

44 保護膜

44a 保護膜の凸部分

44b 保護膜の凹部分

51 アンテナ

52 アンテナ共用器

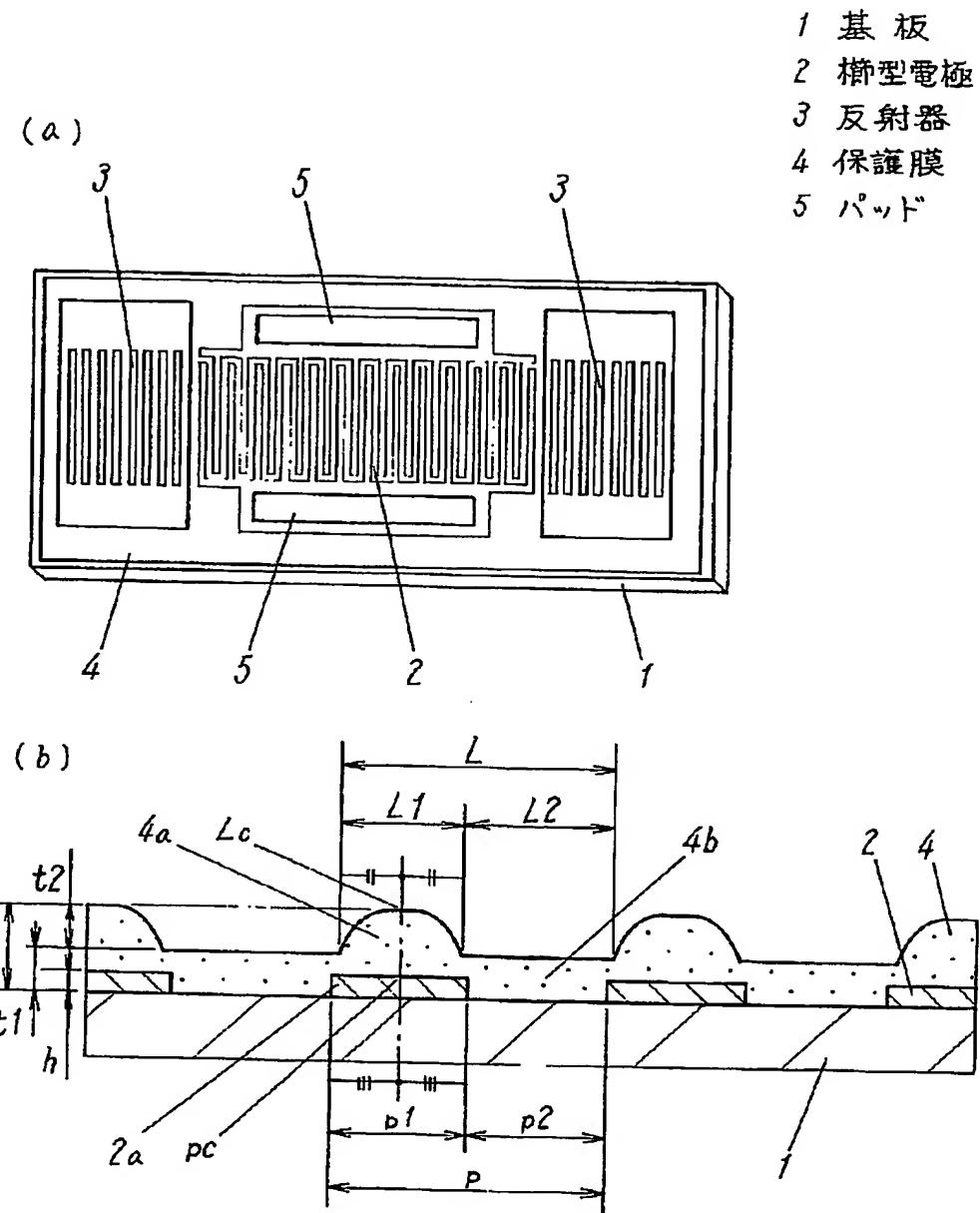
52a 送信用 SAW フィルタ

52b 受信用 SAW フィルタ

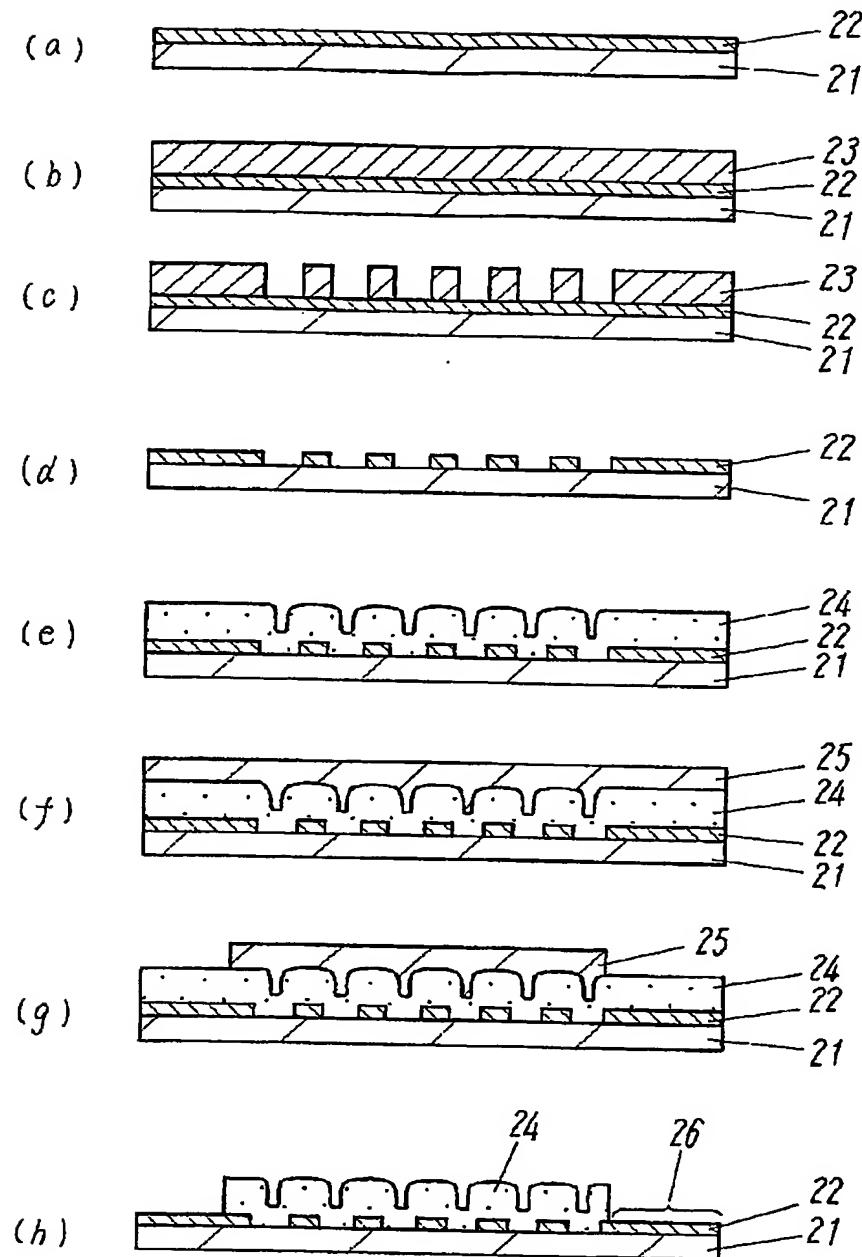
【書類名】

図面

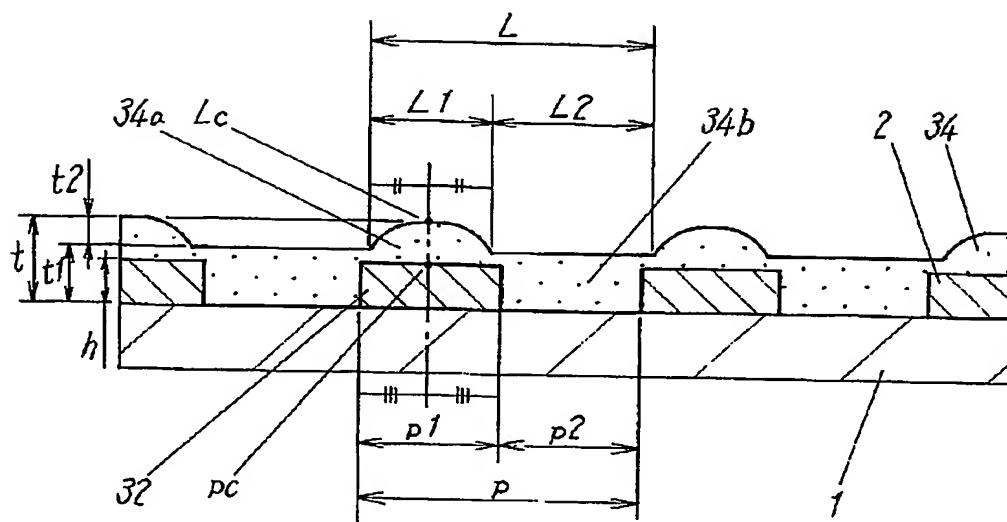
【図1】



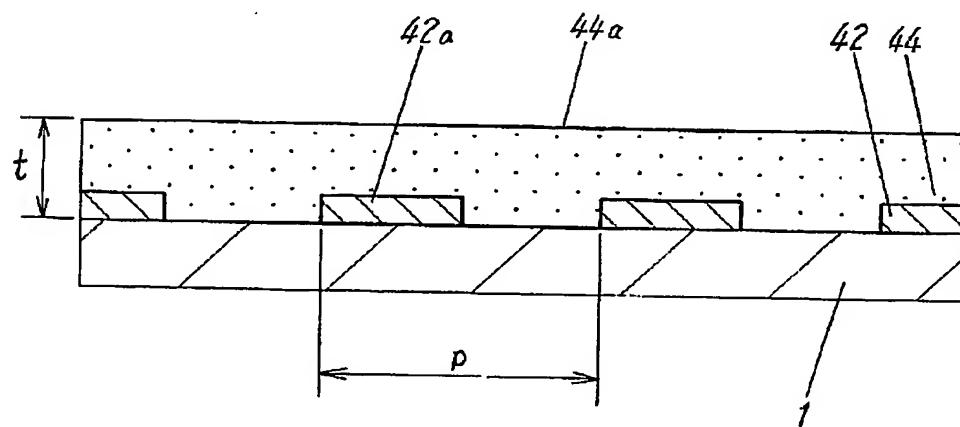
【図2】



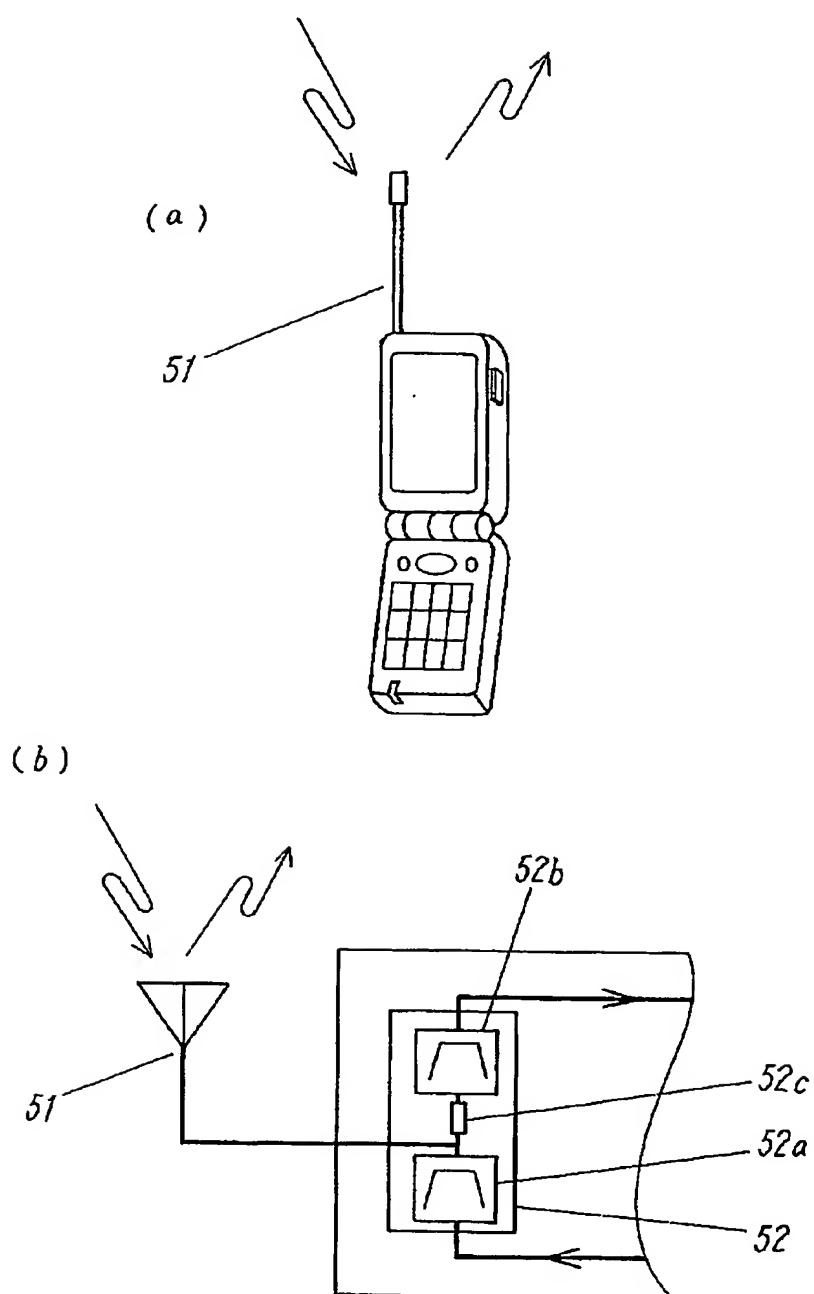
【図3】



【図4】



【図5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電極上に保護膜を形成することによって温度特性および電気的特性が優れた電子部品を得ることを目的とするものである。

【解決手段】 基板1の表面から保護膜4の凸部の頂部までの高さをt、保護膜4と接する基板1の表面から保護膜4の凹部の底部までの高さをt1、保護膜4の凸部の頂部から保護膜4の凹部の底部までの高さ( $t - t_1$ )をt2とし、保護膜4の凹凸形状の1ピッチあたりのピッチ幅をL、保護膜4の凹凸形状の1ピッチあたりの凹凸の凸部の幅をL1、凹部の幅をL2、樹型電極2の1ピッチあたりのピッチ幅をp、樹形電極2を構成する電極指1本あたりの幅をp1、電極指2a間の幅をp2、樹型電極2の膜厚をhとしたとき、「 $h < t_2$ 」(ただし、 $L = p$ 、 $p_1 + p_2 = p$ 、 $L_1 + p_1 L_2 = L$ 、 $L_1 \leq p_1$ 、 $L_2 \geq p_2$ の関係を満たす)である。

【選択図】 図1

特願 2002-374396

出願人履歴情報

識別番号 [000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 大阪府門真市大字門真1006番地  
氏 名 松下電器産業株式会社